

Silicon NPN Transistor

BSX24

32V / 100mA

DATASHEET

OEM – SEL

Source: SEL Databook 1965



Silizium-Planar-Transistor

BSX 24**Ausführung**

nnp-Silizium-Epitaxial-Planar-Transistor.
Metallgehäuse, Kollektor ist mit dem Gehäuse verbunden.

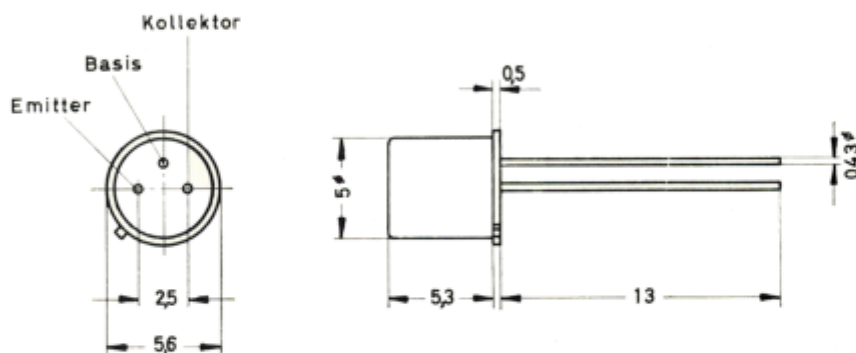
Verwendung

Transistor für allgemeine Schalter- und Verstärkeranwendungen

Abmessungen

(Maße in mm)

Gehäuse TO-18

**Grenzdaten**

Verlustleistung	$T_u = 25\text{ °C}$	P_{tot}	300	mW
	$T_G = 25\text{ °C}$		1	W
Kollektor-Basis-Spannung	$T_u = 25\text{ °C}$	U_{CB0}	32	V
Kollektor-Emitter-Spannung		U_{CE0}	32	V
Emitter-Basis-Spannung		U_{EB0}	5	V
Kollektorgleichstrom		I_C	100	mA
Kollektorspitzenstrom		I_{CM}	250	mA
Sperrschichttemperatur		$+T_j$	175	°C
Minimale Gehäusetemperatur		$-T_G$	55	°C
Maximale Lagertemperatur		$+T_s$	175	°C
Minimale Lagertemperatur		$-T_s$	55	°C

BSX 24**Statische Kenndaten bei $T_U = 25\text{ °C}$**

Kollektor-Basis-Reststrom	$U_{CB} = 20\text{ V}$	I_{CBO}	< 50	nA
Kollektor-Emitter-Restspannung	$I_C = 100\text{ mA}, I_B = 10\text{ mA}$	U_{CEsat}	< 0,35	V
Gleichstromverstärkung	$U_{CE} = 5\text{ V}, I_C = 50\text{ mA}$	B	> 35	
Wärmewiderstand	ohne Kühlfläche	R_{thU}	0,5	$^{\circ}\text{C/mW}$
	(Sperrschicht-Gehäuse)	R_{thG}	0,15	$^{\circ}\text{C/mW}$

Dynamische Kenndaten bei $T_U = 25\text{ °C}$

Emitterschaltung				
Grenzfrequenz	$U_{CE} = 10\text{ V}, I_C = 10\text{ mA}$	f_T	200	MHz
Einschaltzeit	$I_{B1} = 3\text{ mA}, I_{B2} = 2\text{ mA}$	t_{EIN}	25	ns
Ausschaltzeit	$I_C = 10\text{ mA}, U_{CC} = 3\text{ V}$	t_{AUS}	400	ns
Speicherzeit	$I_{B1} = I_{B2} = I_C = 10\text{ mA}$ $U_{CC} = 10\text{ V}$	t_s		
Ausgangskapazität	$U_{CB} = 5\text{ V}$	C_{ob}	5	pF

**BSX 24**